用于高电压环境下的光学电压电场传感器

冯 运¹ 陈洪波¹ 白 χ^1 王 靖² 马剑辉²

(1. 四川电力科学研究院 四川 成都 610072;2. 武汉康普常青软件技术有限公司 湖北 武汉市 430071)

摘 要:复杂电磁环境下电量信号的采集一直是国内外研究的热点。基于 BGO 晶体的光电效应原理,提出了一种绝缘子串电场强度的测试方法,并开发出新型光学传感器,其具有抗干扰能力强、尺寸小、绝缘性能好等优点,具有广阔的应用前景。

关键词:光学;电压;电场;传感器

Abstract: It is a hot spot of the researches on the acquirement of the electric signal in complex electromagnetic environment both at home and abroad. Based on photoelectric effect of BGO crystal , a testing method to get the electric field intensity of insulator strings is presented , and a new type of optical sensor is developed with the strong interference rejection , small size and good insulation ability , which has a broad application prospects.

Key words: optics; voltage; electric field; sensor

中图分类号: TM835 文献标志码: B 文章编号: 1003 - 6954(2013) 02 - 0059 - 04

0 引 言

自 1970 年半导体激光器在室温连续工作和低 损耗光纤实现之后,随着两者的飞速发展,光纤通 信和光纤传感技术的应用领域显著扩大。近年来, 为适应大规模、大容量电力系统的需要,尤其是遥 控、遥测和人工智能等开发研究中的特殊需要,针 对光纤传感技术的研究蓬勃发展,利用光纤的无感 性、绝缘性、细径性、柔软性、耐热性、耐腐蚀以及低 损耗传输等电气物理特性研制成的原理新颖、种类 繁多的光纤传感器,应用领域涉及电磁噪声下的检 测、雷电检测、安全检测、狭小空间的检测、移动体 内部检测以及在高温、化学气氛、水下和空间的检 测。检测参数包括电场、磁场、温度、压力、位置、移 动和转动等。下面将对最新研制成功的利用锗酸秘 电光效应的光纤电压传感器和电场传感器的原理结 构和基本特性进行探讨。

1 电光效应测量电压电场原理

光纤电压电场传感的结构主要由传感头、信号 传输光纤及测量系统组成,以工作波长为1550 nm 的 LED 作为光源; PIN 光电二极管(或光电倍增管) 光电接收组件作为光探测器,用单模光纤传输光信 号; 传感头由起偏器、BGO 晶片、1/4 波长片、检偏器 和短程透镜构成。LED 光源发出的光经透镜准直, 由起偏器变成线偏振光,1/4 波长片将线偏振光再 变成圆偏振光,之后穿过处于电压或电场中的 BGO 晶体,由于加在 BGO 上的电压或电场的作用,这个 圆偏振光转换成椭圆偏振光。经检偏器检偏后的光 信号其调制度相当于交流电压和电场,光电平的相 对大小则对应着直流电压或电场。因而,加在 BGO 上的电信号就可通过检测光信号来测量。



在没有外电场及干扰双折射时,BGO 晶体是光 学各向同性体,其逆介电张量为

 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_0 = 1/\varepsilon_0$ $\beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$

在外加电场 *E* 的作用下 ,BGO 晶体的折射率椭 球方程为

• 59 •

 $(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) / n_0^2 + 2\gamma_{41} (E_{1x2} x_3 + E_2 x_1 x_3 + x_1 x_2) = 1$

当通光方向和外加电场方向平行时,电场作用 下的光轴方向为 *y*₁*y*₂*y*₃,调制偏振光振动方向为 *y*₁*y*₂ 如图1所示。

折射率椭球方程为

 $(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) / n_0^2 + 2\gamma_{41} (E_1 x_2 x_3 + E_2 x_1 x_3 + E_3 x_1 x_2) = 1$

由于在 $x_1x_2x_3$ 坐标系和 $y_1y_2y_3$ 中 x_3y_3 重合,因 此令 $x_3 = 0$ 等效于 $y_1y_2y_3$ 坐标系令 $y_3 = 0$ 。因此令 $x_3 = 0$,可求得偏振光振动面上椭圆方程为

 $(x_1^2 + x_2^2) / n_0^2 + 2\gamma_{41}E_3x_1x_2 = 1$

上式表明 *E*₁、*E*₂ 并不影响偏振光的振动方向和 折射率。对椭球方程主轴化为

$$x = Qy$$
, $Q = (e_1 e_2)^{\mathrm{T}}$

其中 $e_1 = [\cos \pi/4, \sin \pi/4]$, $e_2 = [\cos \pi/4, \sin(-\pi/4)]_{\circ}$

 $(\beta_0 + \gamma_{41}E) y_1^2 + (\beta_0 - \gamma_{41}E) y_2^2 + \beta_0 y_3^2 = 1$

新坐标系的两个坐标轴方向是原坐标轴绕电场 方向 y₃ 旋转45°而成 ,且与电场无关(坐标变换矩阵 Q 是一个与 E 无关的量)。主轴化后的椭圆方程直 观地表示了振动平面上的两个主轴方向的双折射 率。

$$n_{1} = n_{0} - (1/2) n_{0}{}^{3} \gamma_{41} E$$
$$n_{2} = n_{0} + (1/2) n_{0}{}^{3} \gamma_{41} E$$
$$\triangle n = n_{0}{}^{3} \gamma_{41} E$$

两个偏振方向光程差 Δn^* $l = n_0^3 \gamma_{41} E$ 相位差 $\delta = (2\pi/\lambda) n_{03} \gamma_{41} E l_{\circ}$

由上式看出 相位差仅δ和电场强度一个变量相 关 且关系为线性 其他均为 BGO 晶体的材料常数, 该相位差通过偏光干涉的方法转变为光强度信号 P。

包含相位信息的光强度信号耦合入单模光纤的 光线经过 BGO 传感头 在被测电压或电场的调制下 到达 PIN 二极管,经过光电接收组件(由前置跨阻 放大器,AGC 放大电路组成)。滤波电路将其分离 成直流和交流两部分,探测到的光功率交流分量 *P_{Ac}*和直流分量*P_{DC}*的比值*P_{AC}/P_{DC}*和被测交流电场 线性相关。

当施加到 BGO 上的电场信号较弱时,输出光信 号的强度调制为

 $P = 1/2P_0(1 + K^* E_0 \sin\omega t)$

其中 P₀ 为入射到 1/4 波长片表面的光强; K 为和

BGO 尺寸和封装外壳材料形状相关的常数; E_0 为电场强度 ,于是 $P_{AC}/P_{DC} = K^* E_0^* \sin \omega t_{\circ}$

因此,来自光源、光探测器的能量涨落以及系统 中光纤连接,耦合的变化均可以得到消除。

在这个 BGO 光学电场传感器测量系统中,LED 耦合到单模光纤中的能量非常微弱 約为1~2 μW, 由于起偏器、检偏器和1/4 玻片的存在,传感器的插 入损耗在8~10 dB 之间,因此光电探测器实际上能 接收到的光能量仅为100 nW级。因此对光电探测 组件的要求需要能够测量 nW 量级光功率。

对于电场分布的测量,BGO 电场传感器体积需 要做得尽可能小,所有的光学元件需要用环氧树脂 粘接和包封以满足电气性能和机械强度的要求。因 为传感头本身对空间电场在一定距离内会略微使得 电场强度畸变,减小封装材料的介电常数可以减少 这种影响。此外,BGO 传感头与光纤耦合应采用有 机和无机绝缘材料做成的连接器,以保证高绝缘性 和无感性。

2 基本特性试验

以大型平板电极作为高电位,试验台面为地,分 别以不同高度的绝缘柱做支撑,使平板电极和桌面 平行。平板电极1 m x 1 m ,厚度2 mm ,不锈钢材 料。桌面不锈钢材料,长方形,尺寸略大于上极板。 晶体通光方向长度 d = 5 cm ,折射率 $n_0 = 2$,介电常 数 $\varepsilon = 16$,有效电光系数记为 γ 约 1 pm/V。

试验的2种方式调制为:(1)直接放在地极板 表面 极板间隔23 cm;(2)横向放置于塑料杯顶部, 高度约为23 cm,极板间隔43 cm,如图2所示。试 验结果如表1所示。



图 2 试验布置图

	表1 传感器调制试验结果					
编号	极板间距	加载电压	电场强度	感应电压		
	/m	/kV	/(kV \cdot m ⁻¹)	/mV		
1	0.23	45.1	196	944		
2	0.43	50.0	116	413		

由电光效应导致的偏振态附加相位差的测量值 $\Delta \delta$ 测 = $U/U_0 \Delta_1 = 0.050 \Delta \delta_2 = 0.022$ 。

由于相位差 $\delta = (2\pi/\lambda) n_0^3 \gamma_{41} El$,即电场强度 测量值 $\Delta \delta_1 = (2\pi/\lambda) n_0^3 \gamma E_1 d = (2\pi/1.55 \mu m) \times 2^3 \gamma E_1 \times 5 \text{ cm}$,计算可得 $E_1 = 30.8 \text{ kV/m}; \Delta \delta_2 = (2\pi/\lambda) n_0^3 \gamma E_2 d = (2\pi/1.55 \mu m) \times 2^3 \gamma E_2 \times 5 \text{ cm}$,计 算可得 $E_2 = 13.6 \text{ kV/m}$ 。

由于晶体本身介电常数为 16,理想情况下,如 果晶体和空气之间界面为无限大,则其感应电场应 为临近空气中电场的 1/16 = 0.062 5,但实际上,晶 体本身的尺寸是有限的,而且其形状也会影响附近 的空间电场分布,研究表明,晶体尺寸越小,其内电 场感应强度越接近于空气中的实际电场。

同时从试验结果可以看出:(1) 晶体悬空和晶 体贴近地电极的感应电场灵敏度有较大区别,原因 是由于平板电极形成的空间电场在靠近上下极板的 位置有较大的畸变,因此需要以悬空测量的数据作 为标定量;(2) 由于条件限制,传感头虽然有很小的 介电常数,但在高电压环境下,表面的感应电荷也会 对测量结果造成影响。

3 应 用

在各类输、变电电气产品的研究、设计、试验和 制作过程中,最为突出的是电气绝缘设施和电场防 护等问题,需要检测不同部位的电压和电场分布。 现有的典型检测手段(静电电压表)除体积大、精度 低和操作频繁外,其抗干扰能力差,同时本身会严重 影响坏境本身电场分布,因此往往不能反映真实情 况。光学电场互感器除占用空间小、响应速度快、抗 干扰能力强以外,最突出的优点就是传感头和信号 传输通道都不含有任何金属,且由介电常数低的材 料组成,对电场分布影响基本可以忽略,特别是在高 电压场合,极佳的绝缘性能保障了操作人员的安全, 是目前的理想电场检测手段。

由于 BGO 晶体不仅是优良的电光晶体,而且还 有优良的电气物理性能。因此,其灵敏度高,测量范 围广 输入阻抗高 ,抗干扰能力强 ,几乎不受温度影 响 ,目前正在许多领域获得应用。

(1) 电压测量

由于 BGO 传感器是无感和高输入阻抗的,所以 可以对高压输电配电系统电气设备进行无感、安全 快速和遥控测量。例如对多级串联超高压绝缘子分 压的测量,可以得知每一个绝缘子承担的电压值。

(2) 电场测量

不适合狭小空间和表面电场分布的测量。例 如 高压架空线绝缘子周围电场分布测量 通过电场 分布判断绝缘子运行状况。

(3) 高频冲击波的监测

BGO 传感器的输入阻抗高、测量频带宽、响应 速度快,适合于输电网高频电压波动的分析及冲击 试验和雷电冲击波形的观测与监视。

4 结 语

从电光效应基本原理出发,探讨了 BGO 晶体光 学电压电场传感器的原理、结构、基本特性及其应 用。提出并通过试验验证了传感头本身对电场分布 造成的影响,同时与传感头内感应电场强度和传感 头放置位置以及方向相关,说明了传感头尺寸以及 封装材料对电场测量是至关重要的,应选用小介电 常数的非金属材料制成小尺寸表面光滑的封装外 壳。

光学电场电压传感器是以其绝缘强度高,抗干 扰能力态范围大、体积小、频带宽、绝缘性能好和无 爆炸危险等优点使其在电力系统中发挥越来越重要 的作用,势必成为新一代电力监测技术的主流。

参考文献

- [1] 夏强峰. 瓷质悬式绝缘子劣化非接触式检测方法的研究[D]. 重庆: 重庆大学 2010.
- [2] 蒋兴良,夏强峰,胡琴,等. 劣化绝缘子对悬垂串电场 分布特性的影响[J]. 中国电机工程学报,2010,30 (16):118-124.
- [3] 李洪杰, 王颖. 绝缘子串周围静电场的数值计算及其 结果在故障绝缘子检测方面的应用[J]. 电瓷避雷器, 1997(4):8-10.
- [4] Birlasekaran S ,Li H J. Detection of Faulty Insulators on Power Transmission Line [C]. Power Engineering Society Winter Meeting Singapore 2000.

- [5] 徐其迎 李日隆. 110 kV 合成绝缘子沿面电场分布的 研究[J]. 绝缘材料 2003(4):48-50.
- [6] 袁小娴 陈俊武 周志成 ,等. 330 kV 线路复合绝缘子 电位和电场分布的有限元计算[J]. 电瓷避雷器 2006 (4):9-12.
- [7] 卢明 阎东 杨庆.均压环安装错误对电场分布的影响[J]. 电瓷避雷器 2010(2):1-3.
- [8] 毛凤麟,王雪松,維峰. 合成绝缘子沿面场强及电位分 布试验研究[J]. 西北电力技术 2000(1):6-8.
- [9] 武坤,司马文霞 杨庆,等. 分域迭代法计算特高压线 路绝缘子电场分布[J]. 高电压技术,2009,35(6): 1279-1283.
- [10] 汪金刚 何为 陈涛 等. 绝缘子表面电场与紫外脉冲 关系以及在劣化绝缘子检测中的应用[J]. 电工技术 学报 2008 23(6):137-142.
- [11] 张占龙,黄丹梅魏昱,等.劣质绝缘子电场正问题优化算法分析[J].重庆大学学报,2009,32(11):1296

(上接第20页)

不设隔离开关,这种情况下,系统可靠性最差,用户 断电时间长;在第3种情况,增加了供电网变压器备 用,缩小了由于变压器检修而产生的停电时间,用户 停电持续时间大大降低;第1种情况在第四种的情 况下增设了隔离开关,因此缩小了停电范围;第2种 情况考虑了断路器的可靠操作率,可以看出,在断路 器能够100%动作的情况下系统的可靠性更高。

	表3	系统可	靠性打	旨标
--	----	-----	-----	----

可靠性指标	第1 种 情况	第 2 种 情况	第3种 情况	第4 种 情况
SAIFI	1.827	1.746	1.827	1.827
SAIDI	5.348	5.031	4.332	7.317
CAIDI	3.416	3.396	2.371	4.003
ASAI	0.995	0.995	0.994	0.998

因此,可以看出,对于同一网络,不同的接线方 式下,其系统可靠性指标有很大的不同。对可靠性 较差的网络,可以采取一定的增强措施,如加装主馈 线隔离开关、加分支线保护、备用供电变压器、增加 备用电源等方式来增加其运行灵活性,从而提高其 可靠性指标。

参考文献

[1] 徐纪法.供电可靠性综述 [J].大众用电,2003(9):36

- 1299.

- [12] 陈涛. 基于非接触式的劣化绝缘子检测方法的研究[D]. 重庆: 重庆大学 2006.
- [13] 王黎明 廖永力,关志成. 紧凑型输电线路复合绝缘
 子轴向电场分布分析[J]. 高电压技术,2009,35
 (8):1862-1868.
- [14] 粟福珩,贾逸梅,王青霞,等. 陡波试验寻找合成绝缘
 子内部缺陷有效性的检验[J]. 电网技术,2003,27
 (1):41-43.
- [15] 孙豹,陈福深.用于测量工频强电场的集成光学电场 传感器[J]. 半导体光电 2010(2):202 – 204.
- [16] 肖悦娱. 光学电压互感器的电场分布对测量的影响 [J]. 高电压技术 2007 33(5):37-40.
- [17] 霍戌文,李伟,李进,等.光电探测微信号放大器设计[J].浙江理工大学学报 2005 22(3):259-262. (收稿日期:2012-12-28)

- 37.

- [2] L G. Monte Carlo Simulation Based Reliability Studies of a Distribution Test system [J]. Electric Power Systems Research 2000, 54 (1): 55 - 65.
- [3] 别朝红,王锡凡.蒙特卡洛法在评估电力系统可靠性的应用[J].电力系统自动化,1997,21(6):68-75.
- [4] 霍利民,朱永利,张在玲,等.贝叶斯网络在供电系统可靠性评估中的应用[J].电工技术学报,2004,19
 (8):113-118.
- [5] 卢锦玲,栗然,刘艳,等.基于状态空间法的地区环式 供电网可靠性分析[J].电力系统自动化,2003(11): 21-27.
- [6] 万国成 任震 (田翔). 供电网可靠性评估的网络等值法 模型研究[J]. 中国电机工程学报 (2003 23(5):48 -52.
- [7] 周云海,曹小伟,危雪.基于网络等值法的配电网可靠 性研究[J].电气开关 2008(2):20-24.
- [8] 汪穗峰.供电网可靠性定量分析研究综述[J].继电器 2008 36(3):78-83.

作者简介:

陈嵩峰(1985),男,工学学士,从事业扩及供用电合同 管理工作;

宋明玉(1985),女,硕士研究生,四川省电力公司乐山 电业局客户服务中心用电信息采集技术专责。

(收稿日期:2012-12-05)